D45XT80

91° 800V 45A

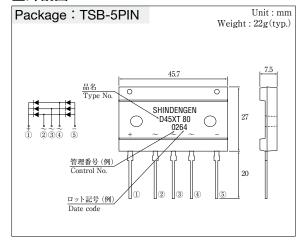
特 長

- 3相ブリッジ
- 薄型 SIP パッケージ
- UL E142422
- 高放熱伝導性

Feature

- 3 Phase-Bridge
- Thin-SIP
- UL E142422
- High Thermal Radiation

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

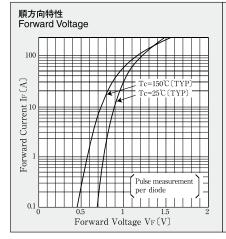
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は Tc=25℃ / unless otherwise specified)

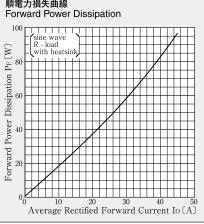
		•			=	
項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions		品名 Type No.	D45XT80	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg				-40~150	$^{\circ}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj				150	${\mathbb C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	Vrm				800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz 正弦波,抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink	Tc = 101℃	45.0	
			フィンなし Without heatsink	Ta=27℃	4.5	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波、非繰り返し 1 サイクルせん頭値、Tj = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj = 25℃			400	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I²t	lms≦t<10ms, 1素子当たりの規格値 per diode		800	A²s	
絶縁耐圧 Dielectric Strength	Vdis	ー括端子・ケース間、AC 1 分間印加 モールド部上面(端子と平行面)は除く Terminals to case, AC 1 minute. Except top(opposite side of the terminal side)of the mold case.		2.5	kV	
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値:1.2 N·m) (Recommended torque : 1.2 N·m)		1.5	N·m	

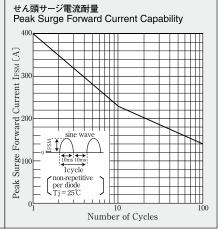
●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は Tc=25℃ / unless otherwise specified)

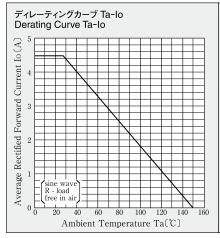
順電圧 Forward Voltage	VF	IF=15A, パルス測定、1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	IR	$ m V_R$ $=$ $800 m V$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μΑ
熱抵抗 Thermal Resistance	θјс	接合部・ケース間 Junction to Case	MAX 0.5	°C/W
	θја	接合部・ 周囲間 Junction to Ambient	MAX 16	

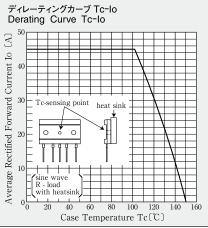
■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS











^{*} Sine wave は 50Hz で測定しています。

^{* 50}Hz sine wave is used for measurements.

^{*}半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。 Typical は統計的な実力を表しています。

^{*} Semiconductor products generally have characterristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.